

# プラズマ計測

## 1. 目的

プラズマテレビでおなじみとなったプラズマは、「第4の物質状態」といわれている。物質の状態は圧力と温度で異なっており、「物質の三態」といえば固体、液体、気体のことである。1気圧下での水を例にとると、0℃以下では固体、0℃～100℃間では液体、100℃以上では水蒸気すなわち気体となる。この水蒸気をさらに加熱していくと、水の分子は解離して水素原子と酸素原子の状態になる。さらに加熱して1万度以上になると、原子は電離して正または負のイオンと電子に分かれて自由に運動するようになる。このような状態では元の物質と全く異なった性質を示し、ほぼ同数の負電荷を持った粒子と、正電荷を持った粒子が混在し(準中性状態)自由に動き回る状態をプラズマと呼んでいる。

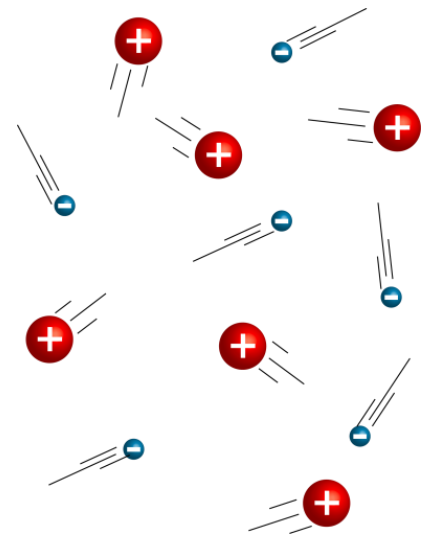


図1 プラズマ概念図

プラズマを利用するには、プラズマの特性を知る必要である。特性として、プラズマの密度や温度がある。プラズマの応用分野は広く、未来のエネルギー源として期待される核融合炉や、小惑星探査機「はやぶさ」のイオンエンジン、集積回路や半導体デバイスの製造、薄膜太陽電池の制作、オゾンの発生やフロン等の有毒ガスの分解などの環境工学など、さまざまである。しかも、各分野で利用されるプラズマの温度や密度は広範囲に及び、その性質は大きく異なっている。たとえば核融合では密度が高く( $10^{20}$  個/ $m^3$ )温度が高い(一億度)プラズマが必要であるが、蛍光灯には低密度( $10^{16}$  個/ $m^3$ )低温(一万度)のプラズマが必要となってくる。このように用途によって最適なプラズマの特性は異なるため、プラズマの特性を把握することがきわめて重要であり、そのために行うのがプラズマ計測である。

本実験では、ECR(Electron Cyclotron Resonance: 電子サイクロトロン共鳴)プラズマ発生装置を用いてアルゴンガスのプラズマを生成し、その中へ静電プローブ(ラングミュアプローブ)を挿入し、電子温度・密度等のプラズマパラメータの計測を行い、プラズマの性質を学ぶことを目的とする。

## 2. 原理

### 2.1 ECR プラズマ

真空中の磁場におかれた電子は、ローレンツ力によって磁力線に巻きつくようにサイクロトロン運動と呼ばれる回転運動を行う。空間的に一様な磁界のもとでの荷電粒子の運動方程式は次式で表される。

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = e\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (1)$$

ここで  $m$  は電子の質量、 $\mathbf{v}$  は速度ベクトル、 $e$  は電荷量(素電荷)、 $\mathbf{B}$  は磁束密度である。

この時の荷電粒子の回転半径を  $r_L$  とすると,

$$r_L = \frac{mv_{\perp}}{|e|B} \quad (2)$$

と表される.  $r_L$  をラーマー半径という.  $v_{\perp}$  は電子の  $B$  に対する垂直な速度成分の大きさである (粒子に働くローレンツ力に寄与する速度は磁界に垂直な成分のみであり, 磁界に平行な速度成分  $v_{\parallel}$  と  $B$  との外積は 0 となり, 等速運動となる). 回転の方向は, 外部磁場の向きに対して荷電粒子の回転によってできる磁界が常に逆を向くような方向である. 従って, 電子は, 磁場に対して右回りの回転運動をする. この回転運動の角周波数を  $\omega_c$  とすると,

$$\omega_c = \frac{|e|B}{m} \quad (3)$$

と表され, この  $\omega_c$  をサイクロトロン角周波数という.

荷電粒子は電場  $E$  によって加速され, 特に電子は  $E$  と逆向きに加速される. したがって, 磁場中の電子の回転方向と逆向きに, 回転する速さが等しい電場をかけると, 電子は電場からエネルギーを吸収し絶え間なく加速する. この現象を電子サイクロトロン共鳴 (ECR) という. ECR プラズマ発生装置では, マイクロ波を使って電子を加速する電場を生成する.  $\omega_c > \omega$  なる強磁場側から入射したマイクロ波はプラズマ中を浸透し, 電子サイクロトロン波と呼ばれる短波長の右回り円偏波を励起する. この電子サイクロトロン波は弱磁場側へ伝播し,  $\omega = \omega_c$  なる層で急激に減衰しエネルギーが電子に吸収される. これが共鳴層で, 電子の旋回方向とマイクロ波電界の偏波面が図2のように常に一致するため, 電子が絶え間なく加速されることによって説明される. 本実験では, 2.45 GHz のマイクロ波を使用しており, 磁束密度  $B=0.0875$  T で ECR が生じる. 共鳴層でエネルギーを得た電子は磁力線にまわりつきながら次々と, 周辺の中性粒子と衝突して中性粒子を電離させる. その結果生じた電子もまた, ECR によって加速され電離に寄与する. この繰り返しで生成されるプラズマが ECR プラズマである. そのため, 比較的大容量で高密度のプラズマが生成される.

## 2.2 静電プローブ(ラングミュアプローブ)

プラズマの計測法にはプラズマから放射されるX線や可視光などの電磁波の計測, レーザーやミリ波, 中性粒子やイオンを照射して, それに対する反応を計測する手法や電極をプラズマに挿入し, そこに流れる電流を計測するプローブ法など様々な方法が存在する. それぞれに一長一短があるが, 本実験では静電プローブ法により測定する. 静電プローブによるプラズマパラメータの測定は, 探針法と呼ばれ, プラズマ中に微小な電極を挿入し, そこから電流を取ることでプラズマ中の荷電粒子密度・温度, エネルギー分布等の情報を局所的に求める方法である.

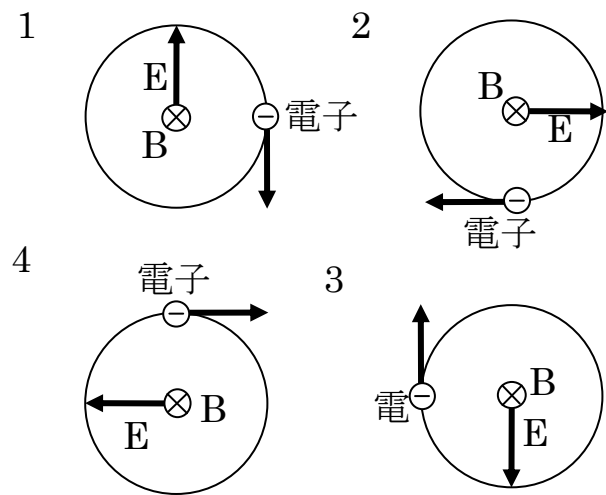


図2. 電子サイクロトロン共鳴の概念

本実験では、図2に示した直径1 mm長さ10 mmの円筒形ラングミュアプローブを使用する。プローブの先端部電極の材質は、融点が高いタングステンを用いている。

このプラズマ中のプローブに外部から電圧を印加すると、プローブ電流  $I_p$  はプローブ電圧  $V_p$  と  $V_s$  との差 ( $\Delta V = V_s - V_p$ ) によって変化する。プローブ電流  $I_p$  の振る舞いはおおまかに3つに分類される。プローブが空間電位  $V_s$  にあるときは、周囲のプラズマと全く同電位であるので、プローブにはプラズマ粒子の熱運動による熱拡散電流が流入する。プローブ表面の単位面積を単位時間内に通過する電子の個数を  $\Gamma_e$  とし、また、電子の速度がマクスウェル分布則に従うとすれば  $\Gamma_e$  は、

$$\Gamma_e = \int_0^{\infty} v dn(v) = n_e \sqrt{\frac{kT_e}{2\pi m_e}} = \frac{1}{4} n_e \langle v_e \rangle \quad (4)$$

ただし  $n_e$ : 電子密度,  $k$ : ボルツマン定数,  $T_e$ : 電子温度,  $m_e$ : 電子質量となる。 $\langle v_e \rangle$  は電子の熱運動平均速度で、

$$\langle v_e \rangle = \sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m_e}} \quad (5)$$

と表される。よって、プローブに流れ込む電子の電流は

$$I_{es} = \frac{1}{4} e S n_e \langle v_e \rangle = \frac{1}{4} e S n_e \sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m_e}} \quad (6)$$

正イオンに関しても同様の仮定をすると

$$I_{is} = \frac{1}{4} e S n_i \langle v_i \rangle = \frac{1}{4} e S n_i \sqrt{\frac{8kT_i}{\pi m_i}} \quad (7)$$

ただし、 $e$  を素電荷,  $S$  をプローブ表面積,  $\langle v_e \rangle$  は電子の熱運動平均速度,  $n_i$  はイオン密度,  $m_i$  はイオン質量,  $\langle v_i \rangle$  は正イオンの熱運動平均速度である。

プローブには電子電流とイオン電流が同時に流入するが、 $m_i \gg m_e$  のために  $T_i$  が  $T_e$  に比べてはるかに大きくない限り  $\langle v_e \rangle \gg \langle v_i \rangle$  が成立する。よって  $I_{e0} \gg I_{i0}$  となるため、プローブには電子電流が流れる。プローブ測定においては電子電流の方向を便宜上正の方向とする。プローブの電位が周りのプラズマの電位よりも正、すなわち  $\Delta V < 0$  の領域ではイオンはプローブ表面から追い返され、電子は逆に引き寄せられるため、プローブ表面には電子鞘(電子シース)が形成され、正電圧の増加に伴い電子電流は増大する。これが図4の(I)の領域である。この領域では正電圧を極端に増やすと、プローブを電極とした放電状態が始まり、電流が急激に増大し、プローブが焼損破壊される恐れがあるので注意が必要である。

空間電位  $V_s$  より負の電圧を印加すると、プラズマに対してプローブはマイナスのポテンシャル



図3 プローブ外形

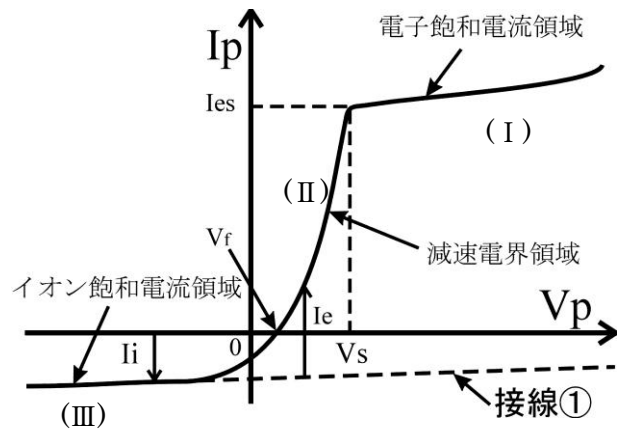


図4 電流－電圧特性

となるため、負に帯電している電子は減速される。結果として、この電位差  $\Delta V$  に打ち勝つ運動エネルギーを持つ電子のみがプローブ表面から流れ込み、 $\Delta V$  以下の運動エネルギーしかもたない電子はプローブ表面に形成された電界によって追い返され、電子電流が減る。一方で、イオンは引き寄せられ、イオン電流は増加する。しかしながら電子電流はイオン電流に比べて断然大きいので、見かけ上依然として電子電流が流れる。この領域において、無衝突プラズマかつ電子は統計的に等方的な速度分布  $f(v)$  に従って運動しているとする。  $v$  から  $v+dv$  の範囲の電子密度は  $f(v) dv$  である。電子はシース端ではプローブ表面の法線に対し角度  $\theta$  で入射する。速度  $v$  の電子は  $v \cos \theta \geq v_{\min} = (2e\Delta V/m)^{1/2}$  においてプローブに入っていける。よってプローブに流れ込む電流  $I_e$  は表面積  $S$ 、密度  $N_e f(v) dv$ 、速度成分  $v \cdot \cos \theta$ 、速度空間の寸法  $2\pi v \cdot \sin \theta v d\theta$  の積によって決まる。よって電子電流  $I_e$  は  $0 \leq \theta \leq \cos^{-1}(v_{\min}/v) = \theta_{\max}$ 、 $v_{\min} \leq v \leq \infty$  での積分

$$\begin{aligned} I_e(\Delta V) &= eN_e S \int_{v_{\min}}^{\infty} dv_e \int_0^{\theta_{\max}} d\theta 2\pi v \cdot \sin \theta v \cdot v \cdot \cos \theta f(v) \\ &= 2\pi eN_e S \int_{v_{\min}}^{\infty} v^3 f(v) \cdot dv \frac{1}{2} [1 - \cos^2(\theta_{\max})] = \pi eN_e S \int_{v_{\min}}^{\infty} v^3 \left(1 - \frac{v_{\min}^2}{v^2}\right) f(v) \cdot dv \end{aligned} \quad (8),$$

実際の粒子は様々な向きに運動するので、速度の大きさだけについて考える場合、異なった向きの粒子を全部勘定に入れなければならない。従って、 $n_e$  個のうち速度の絶対値が  $v$  と  $v+dv$  の間に入る数は速度空間で原点を中心とする半径  $v$  厚さ  $dv$  なる球殻の中にはいる速度点の数に等しいので、この球殻の体積  $4\pi v^2 dv$  をかけて  $4\pi v^2 f(v) dv = F(v) dv$  を代入し

$$I_e(\Delta V) = \frac{1}{4} eN_e S \int_{v_{\min}}^{\infty} v \left(1 - \frac{v_{\min}^2}{v^2}\right) F(v) \cdot dv \quad (10),$$

電子のエネルギー分布関数をマクスウエル分布と仮定すると  $F(v)$  は、

$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m_e}{2\pi kT_e}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{m_e v^2}{2kT_e}\right) \quad (11),$$

$\frac{1}{2} m_e v^2 = E$  とおくと、

$$\begin{aligned} I_e(\Delta V) &= \frac{1}{4} eN_e S \sqrt{\frac{8kT_e}{m_e \pi}} \int_{e\Delta V}^{\infty} \left(1 - \frac{e\Delta V}{E}\right) \left(\frac{E}{kT_e}\right) \exp\left(-\frac{E}{kT_e}\right) \frac{1}{kT_e} \cdot dE \\ &= \frac{1}{4} eN_e S \sqrt{\frac{8kT_e}{m_e \pi}} \exp\left(-\frac{e\Delta V}{kT_e}\right) \\ \therefore I_e(\Delta V) &= I_{es} \exp\left(-\frac{e\Delta V}{kT_e}\right) \end{aligned} \quad (12).$$

式(12)より図4の(II)の領域で示されるように、プローブ電位  $V_p$  が空間電位  $V_s$  から離れて小さくなるほど、すなわち負にいくほど電子電流は減少し、浮動電位  $V_f$  の点でプローブ電流は0になる。これはこの点でイオン電流と電子電流が釣り合っているからである。さらに負にすると、電子電流はさらに減少するので、プローブには正のイオン電流が流れるようになる。これが図4の(III)の領域である。プローブ電位が十分に負である領域では電子はポテンシャルで追い返されるためプローブに流れ込むことは困難であるため、プローブ電流  $I_p$  はほぼ  $I_i$  に等しいと見なしてよい。

### 2.3 解析手法

式(12)の両辺で自然対数を取り, さらに  $V_p$  で微分すると  $\ln\{I_{e0}\}$  は定数なのでゼロとなり,  $\Delta V = V_p - V_s$  であるため, (12)は

$$\frac{d}{dV_p} \ln I_e = \frac{e}{kT_e} \quad (13)$$

よって電子温度  $T_e$  を求めようとする測定されたプローブ電流をイオン電流と電子電流に分け, 電子電流の対数を電圧  $V_p$  に対して微分すれば求まる.

まずはプローブ電流から電子電流を推定する必要がある. プローブを十分負に印加した領域では前述の通り, プローブ電流はイオン電流と見なせるのでその領域で図4に示す接線①を引き, これを  $I_i$  と見なして,  $I_p$  と  $I_i$  の差から  $I_e$  を求める. 理論上では円筒プローブではプローブ電圧のルートに比例するが, 端効果により円筒が楕円状になるため, 結果的に電圧に比例すると考えられる.  $I_e$  の自然対数を一点一点取るのもいいが, 今回は片対数グラフに画くことにより電子温度を算出する. X 軸に  $V_p$  を, Y 軸にプローブ電流からイオン電流の補正を行い得られた電子電流  $I_e$  をにプロットする.  $T_e$  の値は,  $V_p < V_s$  領域の  $I_p$  の勾配より求めるが, 勾配を求めるための接線②の引き方で値が大小する.  $I_e$  の値が小さい領域では,  $I_e$  がイオン電流の補正によって大きく変化する. また,  $T_e$  は通常最小になるように決定するので,  $I_e$  の値が大きい, すなわち,  $V_s$  に近い部分に接線を引き, その勾配から  $T_e$  を求める.

プラズマ空間電位  $V_s$  において図4の電子が減速される減速電界領域から電子飽和電流領域へと折れ曲がりを生ずるはずであるが, 実際は図5に示すように穏やかな曲線を描く. これはプローブそのものがプラズマを乱しているために起こるものと考えられている. はっきりした曲がり角がないため, 正確な空間電位  $V_s$  を求めるには, いろいろと困難が多い. しかし過去の研究結果から, 空間電位は減速電界領域の電子電流が直線からずれ始めた点であるとされている. しかしこれも曖昧なため, おおよその空間電位を知るために図5に示すように, 減速電界領域の電子電流の近似曲線②と飽和電子電流部分に接線③を引き, 2本の接線が交わる点を  $V_s$  とする.

電子密度  $n_e$  は, 式(6)を用いて電子飽和電流および電子温度から算出するのが一般的である. しかし磁化プラズマにおいてはプローブの電子電流は磁場の影響を受けるためイオン飽和電流から算出したほうが便利である. しかしながらイオン温度  $T_i$  の測定は困難であるため, 式(7)からの算出は難しい. 幸いにもイオンシースの生成条件は電子温度によって決まるため, 先に求めた  $T_e$  の値と図4にイオン飽和電流  $I_{is}$  から式(8)を用いて求める. 空間電位  $V_s$  から  $T_e$  の半分に相当する負電位になるとイオンシースが形成され, このとき流入するイオン飽和電流は次式で与えられる.

$$I_{is} = n_e e S \left( \frac{kT_e}{m_i} \right)^{1/2} \exp\left(-\frac{1}{2}\right) \quad (14)$$

イオン飽和電流から電子密度を求めるのは便利な方法ではあるが十分な注意が必要である. というのもプローブに流れる電流には何らかの理由でプローブ表面から2次電子放出があると, 見かけ上のイオンビーム電流が流れるからである.

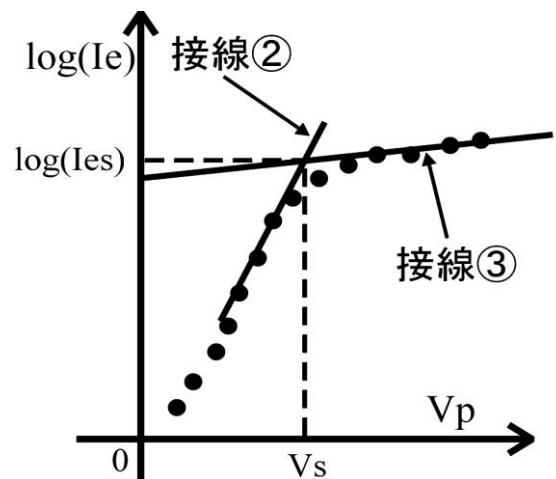


図5. プラズマ空間電位の決定

### 3.実験装置

図 6 に実験装置の概略図を示す. ECR プラズマ生成実験装置は, 内径 40cm 長さ 100cm の真空容器, 2.45GHz マイクロ波電源(最大出力 1500W, 連続発振), 導波管, ガスボックス, 永久磁石, および真空排気装置より構成されている. 実験にはアルゴンガスを使用する. 2.45GHz のマイクロ波が電源より連続モードで供給され, アイソレーター, パワーモニタ, スタブチューナー, 導波管, および石英窓を介して真空容器内へ導入される. ECR 領域(0.0875T)は, 設置した電磁石による磁場内に形成され, プラズマ生成が行われる. プラズマパラメータ測定に使用するラングミュアプローブは, プローブ印加用電源に接続されており, プローブ電圧と電流-電圧変換されたプローブ電流は, それぞれ X-Y レコーダの X 軸, Y 軸に入力され記録される.

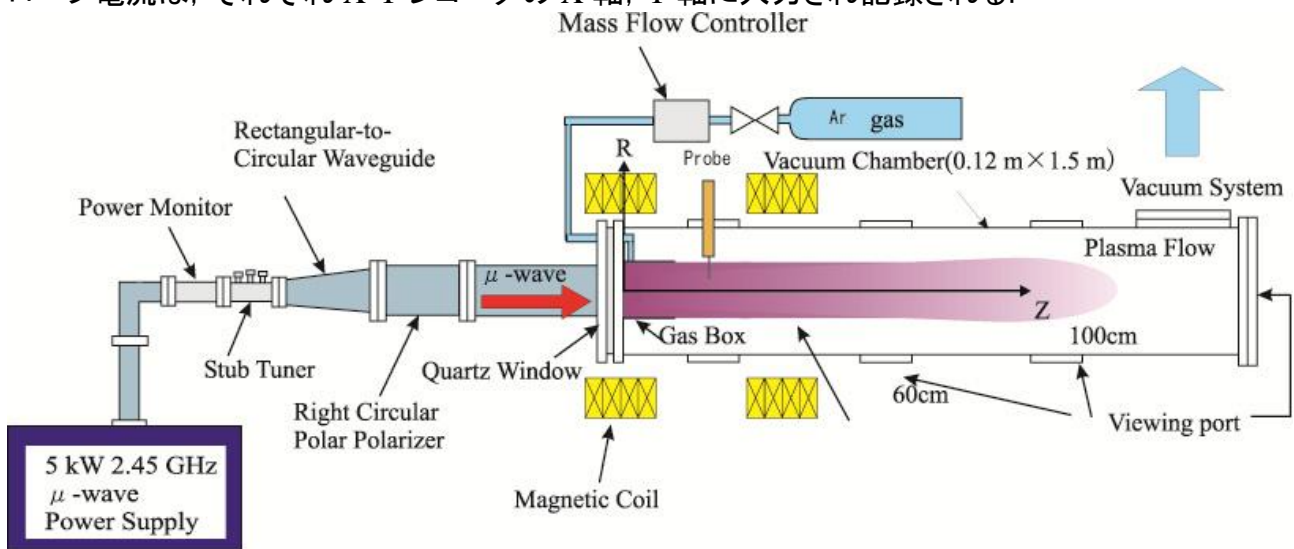


図 6. 実験装置概略図

### 4.実験手順

1. 冷却水を流す
2. 真空ポンプを起動させる
3. 電源を入れる
4. アルゴンガスの配管に設置されたレギュレータを操作し,マスフローコントローラーに 1.5 気圧程度の背圧を与える.
5. 配管途中のバルブを開く
6. マスフローコントローラーを設定し, 8 sccm のアルゴンガスを導入する.
7. マイクロ波電源を操作し, マイクロ波を真空容器内に導入し, ECR プラズマが点火することを確認する.
8. プラズマが点火したら, パワーモニタで反射がゼロになるようにスタブチューナーを調整しながら, マイクロ波入力電力を 100~500W 程度に調節する.
9. プラズマが安定したら, ラングミュアプローブ用の電源のつまみをゆっくり回し, プローブへ

-60~60V の電圧を印加し, X-Yレコーダのペンを動かして(ペンは上げたまま)X-Yレコーダのペン動きを見て, X 軸, Y 軸ともに適当な測定レンジが選ばれていることが確認する.

10. ゼロ点の調整をする

11. 測定レンジを下げて(Ⅲ)の領域のイオン電流を計測するために, プローブに-50V 程度印加しペンを下ろし, 徐々に電圧をあげていき, グラフ用紙に電流-電圧曲線を記録する. 図4に示した様な電流-電圧曲線が得られるはずである.

12. 測定レンジをあげ, (Ⅰ)(Ⅱ)の領域の電流-電圧曲線をえる.

13. 実験条件を変更し, 6-9 を繰り返す.

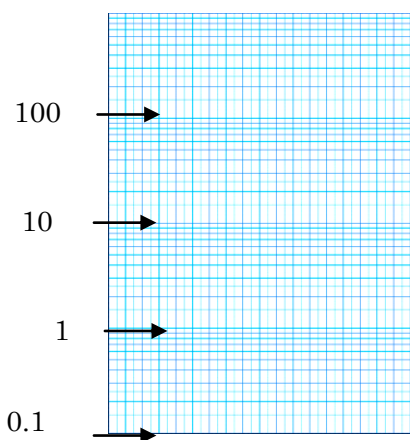
14. 測定がおわったら, 速やかにマイクロ波出力を絞り, マイクロ波電源を切る.

15. アルゴンガスを止め, ポンプを止める.

## 6.実験結果の解析

1. 得られた電流-電圧曲線に, 図4に示した接線①を引く.
2. 電流-電圧曲線の減速電界領域および電子飽和電流領域の値を読み出し, プローブ電圧 ( $V_p$ ), プローブ電流 ( $I_p$ ), 接線①から求めたイオン電流 ( $I_i$ ), および  $I_p$  から  $I_i$  を差し引いた値 ( $I_e: I_p - I_i$ ) を表にまとめる.
3. 図5に示すように,  $V_p$  と  $I_e$  を片対数グラフにプロットする.
4. プロットした片対数グラフに図5の様に接線②, ③を引き, その交点からプラズマ空間電位を求める.
5. 接線②の傾きから電子温度を求める.
6. 電流-電圧曲線(接線①)からイオン飽和電流 ( $I_{is}$ ) を読みとり, 電子密度を求める.

片対数グラフの使い方



$y = \alpha \exp(\beta x)$  を考える.

今,  $X, Z$  をグラフ上の点とすると,

$dX = C_1 dx, dZ = C_2 dY,$

( $dX = 1\text{cm}, dx = 5\text{V}$  なら,  $C_1 = 0.2$ )

( $dZ = 6.3\text{cm}, dY = \text{Log}10 - \text{Log}1 = 2.30$  なら  $C_2 = 2.74$ )

$Z = C_2 Y = C_2 \log(\alpha) + C_2 \beta x$

$\frac{dZ}{dX} = \frac{C_2}{C_1} \beta \Rightarrow \beta = \frac{C_1}{C_2} \frac{dZ}{dX}$

## 7.レポート

1. 実験の概要, 実験で求めた電流-電圧曲線および実験結果の解析で作成した表, グラフ, プラズマ空間電位, 電子温度, 電子密度をまとめる.
2. 実験結果の解析の 1.および 4.では, グラフから接線①~③を求めているが, これらの接線を, 電流-電圧曲線から読み出した値( $V_p, I_i, I_e$ )の最小自乗法による直線近似から求め, プラズマ空間電位, 電子温度, 電子密度を計算し, 1.で得られた結果と比較する.
3. 共同研究者が測定した電子密度・温度と比較してその値の差違が生じた原因を考察する.

余裕があれば

4. プラズマの応用例を一つあげ, プラズマのどのような性質が使われており, それによってどのような利点が挙げられるのかを論ずる
5. 電子飽和電流から求めた電子密度とイオン飽和電流から求めた電子密度をそれぞれ求め, 差異があれば, どのような原因でこの差が生じるのか考察する.
6. 緑色のプラズマにするためにはどうすればよいか.

### 注意!

実験には物差しと関数電卓を持ってきてください.

中島研究室のWEBに実験の手引きの PDF があります.

<http://art.aees.kyushu-u.ac.jp/>

### 参考文献

- 1) 堤井 信力, 「現代のプラズマ工学」, ブルーボックス B-1158, 講談社.
- 2) 高村秀一, 「プラズマ理工学入門」, 森北出版.
- 3) 雨宮 宏, 「4.静電プローブでプラズマを探る」, プラズマ・核融合学会誌, 第 69 巻 8 号, pp.934-938(1993).
- 4) 赤崎 正則, 村岡 克紀, 渡辺 征夫, 蛸原 健治, 「プラズマ工学の基礎」, 産業図書.
- 5) 堤井 信力, 「プラズマ基礎工学」, 内田老鶴圃.
- 6) 林 泉, 「プラズマ工学」, 朝倉書店.

### Nomenclature

- $S$  = surface area of probe =  $3.22 \times 10^{-5} \text{ m}^2$   
 $e$  = electronic charge =  $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$   
 $k_B$  = Boltzmann's constant =  $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$   
 $m_e$  = electron mass =  $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$   
 $m_i$  = ion mass (Argon) =  $6.63 \times 10^{-26} \text{ kg}$